

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

代理人 木村 満 様 あて名 〒101-0054 日本国東京都千代田区神田錦町二丁目7番地 協販ビル2階		PCT 国際調査機関の見解書 （法施行規則第40条の2） [PCT規則43の2.1]	
		発送日 （日.月.年） 04.04.2006	
出願人又は代理人 の書類記号 05F052-PCT		今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2006/301489	国際出願日 （日.月.年） 30.01.2006	優先日 （日.月.年） 10.02.2005	
国際特許分類（IPC）Int.Cl. H01L29/739 (2006.01), H01L29/78 (2006.01), H01L27/04 (2006.01), H01L21/28 (2006.01)			
出願人（氏名又は名称） サンケン電気株式会社			

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から2月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 24.03.2006	
名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 小野田 誠 電話番号 03-3581-1101 内線 3498

様式PCT/ISA/237（表紙）（2005年4月）

## 第 I 欄 見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

- ☒ 出願時の言語による国際出願  
☐ 出願時の言語から国際調査のための言語である \_\_\_\_\_ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文  
(PCT規則12.3(a)及び23.1(b))

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、  
以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表  
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 紙形式  
☐ 電子形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれていたもの  
☐ この国際出願と共に電子形式により提出されたもの  
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出されたもの

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-11	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲	1-11	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-11	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

請求の範囲1-11について

国際調査報告において提示した文献1 (JP 2004-363327 A) 及び文献2 (JP 2004-221370 A) には、本願の請求の範囲1における「前記半導体基体の中心側に、前記第3半導体領域が前記第2半導体領域に対して第1の割合で占める第1の領域が形成されており、前記半導体基体の外周側には、前記第3半導体領域が前記第2半導体領域に対して前記第1の割合よりも大きい第2の割合で占める第2の領域が、前記第1の領域を包囲するように形成されている」点、請求の範囲7における「前記第3半導体領域は、第1の方向に沿って、その前記第2半導体領域に占める割合が前記半導体基体の中心部より周辺部が大きくなるように形成されるとともに、前記第1の方向と直交する第2の方向に沿って、前記第3半導体領域の前記第2半導体領域に占める割合が前記半導体基体の中心部より周辺部が大きくなるように形成されている」点、請求の範囲10における「前記絶縁膜は、前記半導体基体の中心領域に、第1の厚さで形成された第1の領域と、前記第1の領域よりも薄い第2の厚さで形成され、前記半導体基体の外周側に前記第1の領域を包囲するように形成された第2の領域と、を備える」点、請求の範囲11における「前記第2半導体領域は、前記半導体基体の中心側に第1の不純物濃度に形成された第1の領域と、前記第1の不純物濃度より低い第2の不純物濃度に形成され前記半導体基体の外周側に前記第1の領域を包囲するように形成された第2の領域と、を備える」点が記載されておらず、本願の当該請求の範囲に係る発明は、新規性・進歩性を有するものと認められる。